

APPARATUS FOR SURFACE TREATMENT USING FLUORINE GAS



Publication number: JP2000319433 Publication date: 2000-11-21

WATANABE KENJI; NIWA KAZUO Inventor: Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

Classification:

- international: B01D53/68; C08J7/12; B01D53/68; C08J7/00; (IPC1-7): C08J7/12; B01D53/68

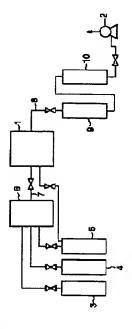
- european:

Application number: JP19990126852 19990507 Priority number(s): JP19990126852 19990507

Report a data error he

Abstract of JP2000319433

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a simple apparatus for the surface treatment of a plastic product and the like with fluorine gas. SOLUTION: This apparatus is mainty composed of a gas-preparing tank 6 equipped with at least a fluorine gas-supplying pipe and a nitrogen gas-supplying pipe connected with respective gas resources, a treating tank 11 connected to the gas-preparing tank by a gas conduit and equipped with an opening capable of being lightly closed, and an exhaust gas-treating apparatus equipped with an active alumina bed for adsorbing at least



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

(P2000-319433A)

(43)公開日 平成12年11月21日(2000.11.21)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード (参考)

CO8J 7/12

B01D 53/68

C08J 7/12

Z 4D002

B01D 53/34

134

C 4F073

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全3頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平11-126852

平成11年5月7日(1999.5.7)

(71)出願人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72)発明者 渡辺 賢治

香川県坂出市番の州町1番地 三菱化学株

式会社坂出事業所内

(72)発明者 丹羽 一夫

香川県坂出市番の州町1番地 三菱化学株

式会社坂出事業所内

(74)代理人 100103997

弁理士 長谷川 曉司

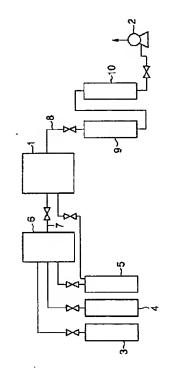
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】フッ素ガスを用いる表面処理装置

(57)【要約】 ·

[課題] フッ素ガスでプラスチック製品などの表面処 理を行うための簡単な装置を提供する。

[解決手段] それぞれのガス源と連絡している少なく ともフッ素ガス供給管及び窒素ガス供給管を備えたガス 調製槽、ガス調製槽とガス導管で連絡されており、かつ 密閉し得る開口部を備えた処理槽、並びに少なくともフ ッ素ガスを吸着するための活性アルミナ床を備えた排ガ ス処理装置から主として成る装置。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 それぞれのガス源と連絡している少なくともフッ素ガス供給管及び窒素ガス供給管を備えたガス 調製槽、ガス調製槽とガス導管で連絡されており、かつ 密閉し得る開口部を備えた処理槽、並びに少なくともフッ素ガスを吸着するための活性アルミナ床を備えた排ガス処理装置から主として成ることを特徴とするフッ素ガスを用いる表面処理装置。

1

【請求項2】 ガス調製槽が、酸素ガス源と連絡している酸素ガス導管を備えていることを特徴とする請求項1 記載の表面処理装置。

【請求項3】 それぞれのガス源がガスポンペであることを特徴とする請求項1又は2記載の表面処理装置。

【請求項4】 排ガス処理装置が活性アルミナ床とフッ 化水素を吸着するためのフッ化ナトリウム床とを備えて いる乾式排ガス処理装置であることを特徴とする請求項 1ないし3のいずれかに記載の表面処理装置。

【請求項5】 排ガス処理装置が系内を排気するための 真空ポンプと連絡していることを特徴とする請求項1な いし4のいずれかに記載の表面処理装置。

【請求項6】 少なくともガス調製槽、処理槽及び排ガス処理装置が、排気装置を備えた気密な遮蔽体内に設置されていることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の表面処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記の装置は大規模な表面処理装置には好適であるが、機構が複雑なので小規 50

模な表面処理装置には適していない。また、希薄なフッ素ガスを用いて表面処理を行なう場合にも、処理槽のガスをガス調製槽に逆流させて排ガスとして処理されるフッ素ガス量を減少させることは、装置を複雑にするに見合うだけの利点は見出せない。従って本発明は、小規模な表面処理や希薄なフッ素ガスを用いて行なう表面処理に好適な表面処理装置を提供しようとするものである。 【0004】

【課題を解決するための手段】本発明に係る表面処理装置は、それぞれのガス源と連絡している少なくともフッ素ガス供給管及び窒素ガス供給管を備えたガス調製槽、ガス調製槽とガス導管で連絡されており、かつ密閉し得る開口部を備えた処理槽、並びに少なくともフッ素ガスを吸着するための活性アルミナ床を備えた排ガス処理装置から主として成っている。

[0005]

【発明の実施の形態】本発明に係る表面処理装置は、ガス調製槽、処理槽及び排ガス処理装置から主として構成されている。ガス調製槽は、フッ素ガス源からフッ素ガスを受入れるためのアッ素ガス等を及び不活性ガスを受入れるための不活性ガスを受入れるための不活性ガスを受入れるための不活性ガスとしては通常は空素ガスを不活性ガスとしては通常はフッ素ガスと混合してある。更にガス調製槽には、通常はフッ素ガスと混合して表面処理に用いる他の反応性ガスをそのガス源から受入れるためのガス導管も備えられている。このような利スとしては、酸素、塩素、二酸化硫黄、臭素及び或る種の有機単量体などが用いられるが、最も一般的なのは対スをの有機単量体などが用いられるが、最も一般的なのは対スをがある。ガス源としては通常はボンベに充填したガスをがある。ガス源としては通常はボンベに充填したガスを開いられる。これによりボンベ出口のガス圧力と流量を設定するだけで、ガス調製槽にそれぞれのガスを所望の組成比となるように供給することができる。

【0006】処理槽は被処理物を収容し、かつガス調製槽からガスを受入れて被処理物の表面処理を行なう容器であり、被処理物を出し入れするための密閉しうる開口部と、ガス調製槽からガスを受入れるためのガス導管を有している。処理槽には異常反応が起きた場合にこれを検知するための温度計と圧力計とを取付けておくのが好ましい。

【0007】排ガス処理装置は系内のガスを無害化して 系外に排出するためのものであり、フッ素ガスを吸着除 去するための活性アルミナ床と、他の除去すべきガスに 応じた適宜の無害化手段を有していて、ガスがこれらを 頃次通過して外部に排出されるようになっている。この ような無害化手段として最も一般的なのは、フッ素処理 により生成したフッ化水素を吸着除去するためのフッ化 ナトリウム床である。排ガス処理装置としては、このよ うに吸着剤を用いた乾式装置を用いるのが、装置が簡単 でありかつ保持も容易なので好ましい。

【0008】本発明の好ましい一態様では、排ガス処理

10

3

装置は真空ポンプに接続されていて、系内のガスを吸引 により排ガス処理装置を経て系外に排出するようになっ ている。また他の好ましい一態様では、装置の主要部で あるガス調製槽、処理槽及び排ガス処理装置は、排気装 **置を備えた気密な遮蔽体内に設置されており、万一ガス** が漏洩しても環境を汚染しないようになっている。

[0009] 図1に示す本発明に係る表面処理装置を用 いてプラスチックの表面処理を行なう1例を説明する と、処理槽1にポリエチレン、ナイロンその他の表面処 理に供するプラスチック製品を収容して蓋を密閉する。 次いで真空ポンプ2を作動させて系内を真空にする。 フ ッ素ガスボンペ3、酸素ガスボンペ4及び窒素ガスボン べ5のバルブを開いて、各ガスを所定の比率となるよう にガス調製槽6に流入させる。ガス調製槽に所定の組成 の混合ガスが形成されたならば、混合ガス導管7のバル ブを開いて混合ガスを処理槽1に流入させる。所定の処 理時間が経過したならば真空ポンプ2を再び作動させ、 かつ排ガス導管8のバルブを開いて処理槽内のガスを活 性アルミナ充填塔9及びフッ化ナトリウム充填塔10を 経て系外に排出する。次いで真空ポンプを停止させ、窒 20 10

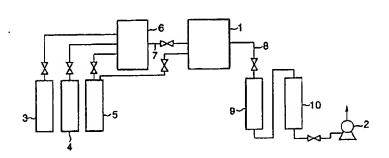
素ガスボンベのバルブを開いて窒素ガスを処理槽に流入 させ、処理槽以降を窒素ガスで置換する。系内が窒素ガ スで十分に置換されたならば処理槽1の蓋を開けて処理 を終えたプラスチック製品を取出す。なお、各バルブの 開閉や真空ポンプの作動 - 停止は、所定のプログラムに 従って自動的に行なわれるように、構成しておくのが好 ましい。

【図面の簡単な説明】

【図1】図は本発明に係る表面処理装置の1例である。 【符号の説明】

- 処理槽 1
- 真空ポンプ 2
- フッ素ガスボンベ 3
- 酸素ガスポンペ 4
- **窒素ガスポンペ**
- ガス調製槽 6
- 7 混合ガス導管
- 排ガス導管 8
- 活性アルミナ充填塔 9
- フッ化ナトリウム充填塔

[図1]



フロントページの続き

Fターム(参考) 4D002 AA22 AA23 BA04 CA07 DA17 DA46 GA02 GB03 GB04 4F073 AA01 BA07 BA29 DA01 DA04 DA09 DA11 GA11